

上海建桥学院教学进度安排表

2012 ~ 2013 学年度第一 学期

课程名称：半导体材料

班级：电科 10B-1, 2

总学时：48

日期	周次 星期	课 程 内 容			授课 方式	上课 地点	作业 布置
		章	节	内 容			
9.3/9.4	1/一、二			半导体材料绪论	讲课	5221/ 5220	
9.10/9.11	2/一、二			半导体材料绪论	讲课	5221/ 5220	
9.14	2/五	1	1-3	硅、锗晶体的制备工艺	讲课	5226	作业 1
9.17/9.18	3/一、二	2	1-3	区熔提纯	讲课	5221/ 5220	作业 2
9.24/9.25	4/一、二	3	1-2	晶体生长概述、理论基础	讲课	5221/ 5220	
9.28	4/五	3	3	熔体晶体生长硅锗的单晶生长	讲课	5226	作业 3
10.1/10.2	5/一、二			国庆节放假			
10.8/10.9	6/一、二	4	1-2	硅锗晶体中杂质的性质和掺杂	讲课	5221/ 5220	
10.12	6/五	4	3-4	硅锗晶体中的位错与微缺陷	讲课	5226	作业 4
10.15/10.16	7/一、二	5	1	硅外延生长	讲课	5221/ 5220	
10.22/10.23	8/一、二	5	2	硅的气相外延生长	讲课	5221/ 5220	
10.26	8/五			期中考试复习	复习		
10.29/10.30	9/一、二			期中考试			
11.5/11.6	10/一、二	5	3-4	外延层电阻率的控制及缺陷	讲课	5221/ 5220	
11.9	10/五	5	5	硅的异质外延	讲课	5226	作业 5
11.12/11.13	11/一、二	6	1	III-V 族化合物半导体的特性	讲课	5221/ 5220	
11.19/11.20	12/一、二	6	2-4	砷化镓的单晶生长方法及制备	讲课	5221/ 5220	
11.23	12/五	6	5	薄膜的生长原理和技术	讲课	5226	作业 6
11.26/11.27	13/一、二	7	1-2	II-VI 族化合物材料制备及性质	讲课	5221/ 5220	

12.3/12.4	14/一、二	7	3-4	II-VI族多元化合物材料及超晶格材料	讲课	5221/ 5220	作业7
12.7	14/五	8	1	氧化物半导体材料制备	讲课	5226	
12.10/12.11	15/一、二	8	2-3	氧化物半导体材料的电学性质及应用	讲课	5221/ 5220	
12.17/12.18	16/一、二	9	1-3	其他半导体材料	讲课	5221/ 5220	
12.21	16/五			期末考试复习	复习	5226	
12.24/12.25	17/一、二			期末考试复习	复习	5221/ 5220	
12.31/1.1	18/一、二			元旦放假、期末考试			

注：授课方式为讲课、实验、习题课、复习、考核，不够写可续页。

任课教师：许玉娥

日期：2012.9.3

系主任审核：

日期：

教学院长审核：

日期：